(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1884 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |

(43) 国際公開日 2005 年10 月20 日 (20.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/097756 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07D 235/20, C09K 11/06, H05B 33/14, 33/22

C07D 235/08, 235/18,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/006605

(22) 国際出願日:

2005 年4 月4 日 (04.04.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-112799 2004 年4 月7 日 (07.04.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 出光興産 株式会社 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 1008321 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河村 昌宏 (KAWAMURA, Masahiro) [JP/JP]; 〒 2990293 千葉 県袖ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP). 山本 弘志 (YAMAMOTO, Hiroshi) [JP/JP]; 〒 2990293 千葉 県袖ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP). 細川 地潮 (HOSOKAWA, Chishio) [JP/JP]; 〒 2990293 千葉県袖ケ浦市上泉 1 2 8 0 番地 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 大谷 保, 外(OHTANI, Tamotsu et al.); 〒 1050001 東京都港区虎ノ門三丁目 2 5番 2号 ブリヂ ストン虎ノ門ビル 6 階 大谷特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: NITROGENOUS HETEROCYCLE DERIVATIVE AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT EMPLOYING THE SAME

(54) 発明の名称: 含窒素複素環誘導体およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

$$R^{1a}$$
 Ar^{1a} Ar^{1

$$R^{4a}$$
 HAr Ar^{2a} HAr Ar^{3a} R^{5a}

$$R^{8a}$$
 R^{10a}
 R^{10a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}

(57) Abstract: A material for organic EL elements which realizes an organic EL element capable of having a high luminescent efficiency even at a low voltage. It is a nitrogenous heterocycle derivative represented by the following general formula (A-1) or (A-2). In the formulae, R1a to R5a each represents a substituent; Ar1a to Ar3a each represents a single bond or a divalent connecting group; HAr represents a group represented by the general formula (A-3) or (A-4); and R^{6a} to R^{10a} each represents a substituent. [Chemical formula 1] (A-1) (A-2) (A-3)(A-4)

(57) 要約: 低電圧においても 高い発光効率が可能な有機 EL 素子を実現する。 下記・記 (A-1) または (A-2) で表される含窒素複素環誘導換合。 る。式中、R^{1a}~ R^{5a}は単結合。 示し、Ar^{1a}~ Ar^{3a}は単結合に、 たは2価の連結基を示す。HAR は一般式(A-3)または(A-4)で表される基を示す。 R^{6a}~ R^{10a}は置換基を示す。 【化1】

WO 2005/097756 A1

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2005/097756 1 PCT/JP2005/006605

明細書

含窒素複素環誘導体およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素 子

技術分野

[0001] 本発明は、新規化合物、および低電圧で高い発光効率を実現し得る有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

背景技術

[0002] 有機物質を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、エレクトロルミネッセンスをELと略記することがある。)は、薄型で安価な大画面フルカラー表示素子としての用途が有望視され、多くの開発が行われている。一般に有機EL素子は、電界を印加することにより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより有機物質が発光する原理を利用した自然発光素子である。

従来の有機EL素子は、無機発光ダイオードに比べて駆動電圧が高く、発光輝度 や発光効率も低かった。最近の有機EL素子は、徐々に改良されているものの、さら に低電圧での高発光輝度および高発光効率が要求されている。

低電圧での高発光輝度および高発光効率の手段として、例えば、ベンズイミダゾール誘導体を電子伝達材料として用いた青色発光素子が開示されている(例えば、特許文献1参照)。この発明では、下記式(a)で表される化合物を電子伝達層として用いており、電流密度20mA/m²で537cd/m²、発光効率2.69cd/Aの青色発光が得られている。また、ベンズイミダゾール環およびアントラセン骨格を有する下記式(b)で表される化合物が開示されている(例えば、特許文献2参照)。しかし、これらの化合物を用いた有機EL素子は、発行効率が十分なものではなく、さらなる高発光効率化が求められていた。

[0003] [化1]

[0004] 特許文献1:特開平10-106749号公報

特許文献2:国際公開WO03/060956号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、低電圧においても高い発光効率が可能な有機EL素子、およびそれを実現する有機EL素子用材料を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、特定の含窒素 複素環誘導体を有機EL素子用材料として用いることにより、上記目的が達成される ことを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。

すなわち、本発明は、以下の含窒素複素環誘導体および有機エレクトロルミネッセンス素子を提供するものである。

1. 下記一般式(A-1)または(A-2)で表される含窒素複素環誘導体。

[0007] [化2]

$$R^{1a}$$
 R^{1a}
 R

[式中、 $R^{1a} \sim R^{5a}$ は置換基を示し、 $Ar^{1a} \sim Ar^{3a}$ は単結合または2価の連結基を示す。 HArは下記一般式(A-3)または(A-4)で表される基を示す。

[0008] [化3]

HAr

$$R^{8a}$$
 R^{10a}
 R^{9a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}

(式中、R^{6a}~R^{10a}は置換基を示す。)]

[0009] 2. 一般式(A-1)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(1-I)または(1-II)で表される上記1に記載の含窒素複素環誘導体。

WO 2005/097756 4 PCT/JP2005/006605

[0010] [化4]

(式中、R¹およびR²は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、R¹およびR²は同時に水素原子ではない。R³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の帰肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁷は、水素原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のトロアリール基から選ばれる基を示す。R⁸およびR¹⁰は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、

置換または無置換のヘテロアリーレン基、および2価の置換または無置換の脂肪族 炭化水素基から選ばれる基を示す。)

3. 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(2-I)または(2-II)で表される上記1に記載の含窒素複素環誘導体。

[0011] [化5]

$$R^{6}$$
 R^{7}
 R^{8}
 R^{7}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、 R^4 および R^5 は、上記 R^1 および R^2 と同様である。 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。 Ar^2 および Ar^3 は、それぞれ独立に上記 Ar^1 と同様である。)

[0012] 4. 一般式(A-1)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(3-I)または(3-II)で表される上記1に記載の含窒素複素環誘導体。

[0013] [化6]

$$R^{3}$$
 R^{1}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{10}

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。)

[0014] 5. 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(4-I)または(4-II)で表される上記1に記載の含窒素複素環誘導体。

WO 2005/097756 7 PCT/JP2005/006605

[0015] [化7]

(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。)

[0016] 6. 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(5-I)または(5-II)で表される上記1に記載の含窒素複素環誘導体。

[0017] [化8]

(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および Ar^2 は上記と同様である。)

- [0018] 7. 一般式(A-3)において、 R^{7a} が置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、一般式(A-1)または(A-2)において、 Ar^{1a} ~ Ar^{3a} が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である上記1に記載の含窒素複素環誘導体。
 - 8. 一般式(1-I)、(2-I)、(3-I)、(4-I)または(5-I)において、 R^7 が、置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、 $Ar^1 \sim Ar^3$ が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である上記2 \sim 6のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。
 - 9. 一般式(1-II)、(2-II)、(3-II)、(4-II)または(5-II)において、 $Ar^1 \sim Ar^3$ が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である上記2 \sim 6のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。
 - 10. 陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層または複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機薄膜層の

少なくとも一層が、上記1~9のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体を含有する 有機エレクトロルミネッセンス素子。

- 11. 含窒素複素環誘導体を、主として発光帯域に含有する上記10に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 12. 含窒素複素環誘導体を、発光層に含有する上記10または11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 13. 有機薄膜層が電子注入層および/または電子輸送層を有し、含窒素複素環誘導体が、電子注入層材料および/または電子輸送層材料である上記10に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 14. 電子注入層および/または電子輸送層が還元性ドーパントを含有する上記1 3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- 15. 還元性ドーパントが、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の内ロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体および希土類金属の有機錯体からなる群から選ばれる一種または二種以上の物質である上記14に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

発明の効果

[0019] 本発明の含窒素複素環誘導体を有機EL素子の有機薄膜層の少なくとも一層に用いることにより、低電圧でありながら、高発光輝度で、発光効率が極めて高い有機EL素子が得られる。

発明を実施するための最良の形態

[0020] 本発明の含窒素複素環誘導体は、下記一般式(A-1)または(A-2)で表されるものである。

[0021] [化9]

$$R^{1a}$$
 Ar^{1a}
 R^{1a}
 Ar^{1a}
 R^{1a}
 R^{1a}

[式中、 $R^{1a}\sim R^{5a}$ は置換基を示し、 $Ar^{1a}\sim Ar^{3a}$ は単結合または2価の連結基を示す。 HArは下記一般式(A-3)または(A-4)で表される基を示す。 [化10]

$$R^{8a}$$
 R^{10a}
 R^{9a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}

(式中、R^{6a}~R^{10a}は置換基を示す。)]

[0022] 上記一般式(A-1)または(A-2)で表される含窒素複素環誘導体のうち、下記一般式(1-I)~(5-II)で表されるものが好ましい。

WO 2005/097756 11 PCT/JP2005/006605

[0023] [化11]

$$R^{3}$$
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{2}
 R^{2}
 R^{2}

(式中、R¹およびR²は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、R¹およびR²は同時に水素原子ではない。R³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁻は、水素原子、置換または無置換の帰肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR¹¹では、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR¹では、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基から選ばれる基を示す。Ar¹は、置換または無置換のアリーレン基、

置換または無置換のヘテロアリーレン基、および2価の置換または無置換の脂肪族 炭化水素基から選ばれる基を示す。)

[0024] [化12]

$$R^{6}$$
 R^{7}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、 R^4 および R^5 は、上記 R^1 および R^2 と同様である。 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。 Ar^2 および Ar^3 は、それぞれ独立に上記 Ar^1 と同様である。)

[0025] [化13]

$$R^{3}$$
 R^{1}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{2}
 R^{10}
 R^{3}
 R^{10}

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。)

[0026] [化14]

(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 および R^{10} は上記と同様である。)

[0027] [化15]

$$R^4$$
 R^7
 R^8
 R^8
 R^8
 R^9
 R^{10}
 R^{10}
 R^9
 R^9
 R^9
 R^{10}
 R^9
 R^9
 R^{10}

(式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} および Ar^2 は上記と同様である。)

[0028] 上記一般式(A-1)または(A-2)で表される含窒素複素環誘導体のうち、一般式(A-3)において、R^{7a}が置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、一般式(A-1)または(A-2)において、Ar^{1a}~Ar^{3a}が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるものが好ましい。また、一般式(1-I)、(2-I)、(3-I)、(4-I)または(5-I)で表される含窒素複素環誘導体のうち、R⁷が、置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、Ar¹~Ar³が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である含窒素複素環誘導体が好ましい。さらに、一般式(1-II)、(2-II)、(3-II)、(4-II)または(5-II)で表される含窒素複素環誘導体のうち、Ar¹~Ar³が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である含窒素複素環誘導体が好ましい。

ここで、上記一般式(1-I)~(5-II)における R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^8 、 R^9 およ

びR¹⁰のハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられ、好ましくはフッ素である。

R¹~R¹⁰の無置換の脂肪族炭化水素基としては、炭素数1~40のアルキル基、炭素数2~40のアルキニル基、炭素数2~40アルケニル基などが挙げられる。アルキル基としては、メチル基、エチル基、1ープロピル基、2ープロピル基、1ーブチル基、2ーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、2ーエチルヘキシル基、3,7ージメチルオクチル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、リフルオロメチル基、1ーアダマンチル基、2ーアダマンチル基、ノルボルニル基、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基などが挙げられ、好ましくは、メチル基、エチル基、1ープロピル基、2ープロピル基、1ーブチル基、2ーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基である。

アルキニル基としては、エチニル基、メチルエチニル基などが挙げられ、好ましくは、エチニル基である。アルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、オレイル基、エイコサペンタエニル基、ドコサヘキサエニル基などが挙げられ、好ましくは、ビニル基、プロペニル基である。

[0029] 上記脂肪族炭化水素基は置換基を有してもよく、置換基としては、例えば、アリール基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル基、pーメチルフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~12、特に好ましくは炭素数0~6であり、例えばアミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジベンジルアミノ基等が挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基等が挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルオキシ基、2ーナフチルオキシ基等が挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基等が挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16

、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等が挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~10であり、例えばフェニルオキシカルボニル基等が挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基等が挙げられる。)、

- [0030] アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 6、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノ基等が挙げら れる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは 炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニ ルアミノ基等が挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニルア ミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等が挙げられる。)、スルファモイル基(好ましくは 炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12であり、例 えばスルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル スルファモイル基等が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より 好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカルバモイル 基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等が 挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~ 16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等が挙 げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16 、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルチオ基等が挙げられる。)、
- [0031] スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル基、トシル基等が挙げられる。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基等が挙げられる。

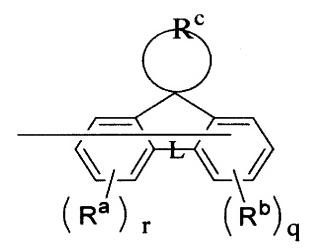
WO 2005/097756 18 PCT/JP2005/006605

)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは 炭素数1~12であり、例えばウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基等が挙 げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸 アミド基等が挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素 原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニト ロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素 原子、酸素原子、硫黄原子を含むものであり具体的には例えばイミダブリル基、ピリジ ル基、キノリル基、フリル基、チエニル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサ ゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、カルバゾリル基等が挙げられる 。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは 炭素数3~24であり、例えばトリメチルシリル基、トリフェニルシリル基等が挙げられる 。)などが挙げられる。これらの置換基はさらに置換されてもよい。また置換基が二つ 以上ある場合は、それらは同一でも異なっていてもよい。また、可能な場合には互い に連結して環を形成していてもよい。

[0032] R¹~R¹⁰の無置換のアリール基としては、炭素数が5~60のものが挙げられ、好ましくはフェニル基、2ービフェニリル基、3ービフェニリル基、4ービフェニリル基、ターフェニリル基、3,5ージフェニルフェニル基、3,4ージフェニルフェニル基、ペンタフェニルフェニル基、フルオレニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーピレニル基、クリセニル基、ナフタセニル基、コロニル基、10ーフェニルーアントラセンー9ーイル基、10ーナフタレンー2ーイルーアントラセンー9ーイル基、12ーフェニルークリセンー6ーイル基、(10ーフェニルーアントラセンー9ーイル)ー4ーフェニル基、(10ーナフタレンー2イルーアントラセンー9ーイル)ー4ーフェニル基、スピロ芳香環基である。スピロ芳香環基とは下記ー般式

WO 2005/097756 19 PCT/JP2005/006605

[0033] [化16]



(式中、R^aおよびR^bは、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、置換または無置換の芳香環、および置換または無置換の複素環から選ばれる基を示す。R^cは環状構造を形成する原子団を示す。R^aとR^bは互いに結合し、環を形成してもよい。rおよびqはそれぞれ0~4の整数である。)

- [0034] で表される化合物である。スピロ芳香環基としては、例えばスピロ(シクロヘキサン-1 , 9'-フルオレン) -2'-イル基、スピロ(シクロペンタン-1, 9'-フルオレン) -2'-イル基、スピロ(インデン-1, 9'-フルオレン) -2'-イル、ジスピロ(ビスフルオレン-9, 10, 9', 9''-9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセン) -2-イル基、ジスピロ(ビスフルオレン-9, 10, 9', 9''-9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセン) -2'-イル基、9, 9'-スピロビフルオレン-2ーイル基などが挙げられる。
- [0035] 上記アリール基は置換基を有してもよく、置換基としては、例えばアルキル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、nーオクチル基、nーデシル基、nーペキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等が挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばビニル基、アリル基、2ーブテニル基、3ーペンテニル基等が挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばプロ

WO 2005/097756 20 PCT/JP2005/006605

パルギル基、3-ペンチニル基等が挙げられる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~20 、より好ましくは炭素数0~12、特に好ましくは炭素数0~6であり、例えばアミノ基、メ チルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジベンジルア ミノ基等が挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素 数1~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメトキシ基、エトキシ基、ブトキ シ基等が挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは 炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルオキシ基、2-ナフチルオキシ基等が挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1~20、より好まし くは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセチル基、ベンゾ イル基、ホルミル基、ピバロイル基等が挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ま しくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12であ り、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等が挙げられる。)、アリール オキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好 ましくは炭素数7~10であり、例えばフェニルオキシカルボニル基等が挙げられる。) 、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ま しくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる 。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好 ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基等が挙げ られる。)、

[0036] アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 6、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノ基等が挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等が挙げられる。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12であり、例えばスルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル

スルファモイル基等が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等が挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等が挙げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルチオ基等が挙げられる。)、

[0037] スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましく は炭素数1~12であり、例えばメシル基、トシル基等が挙げられる。)、スルフィニル 基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばメタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基等が挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは 炭素数1~12であり、例えばウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基等が挙 げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸 アミド基等が挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素 原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニト ロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素 原子、酸素原子、硫黄原子を含むものであり具体的には例えばイミダゾリル基、ピリジ ル基、キノリル基、フリル基、チエニル基、ピペリジル、モルホリノ、ベンゾオキサゾリル 、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、カルバゾリル基等が挙げられる。)、シリル基 (好ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは炭素数3~2 4であり、例えばトリメチルシリル基、トリフェニルシリル基等が挙げられる。)などが挙 げられる。これらの置換基はさらに置換されてもよい。また置換基が二つ以上ある場 合は、同一でも異なっていてもよい。また、可能な場合には互いに連結して環を形成 していてもよい。

[0038] $R^1 \sim R^{10}$ の無置換のヘテロアリール基としては、炭素数3~60のものが挙げられ、好

WO 2005/097756 22 PCT/JP2005/006605

ましくは、フラン、チオフェン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、オキ サジアゾール、ピリジン、ピラジン、トリアジン、ベングフラン、ジベングフラン、ベング チオフェン、ジベングチオフェン、カルバゾール、ベンズイミダゾールおよびイミダゾピ リジンなどの残基から選ばれる基が挙げられる。

上記へテロアリール基は置換基を有してもよく、置換基としては、例えばアルキル基 (好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8 であり、例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、n-オクチル 基、nーデシル基、nーヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロ ヘキシル基等が挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましく は炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばビニル基、アリル基、2 ーブテニル基、3ーペンテニル基等が挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素 数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えば プロパルギル基、3ーペンチニル基等が挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えば フェニル基、p-メチルフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。)、アミノ基(好ましく は炭素数 $0\sim20$ 、より好ましくは炭素数 $0\sim12$ 、特に好ましくは炭素数 $0\sim6$ であり、 例えばアミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジフェニルアミノ 基、ジベンジルアミノ基等が挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~20、 より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメトキシ基、 エトキシ基、ブトキシ基等が挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~2 0、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニ ルオキシ基、2-ナフチルオキシ基等が挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1 ~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセ チル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基等が挙げられる。)、アルコキシカル ボニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭 素数2~12であり、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等が挙げられ る。)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数 7~16、特に好ましくは炭素数7~10であり、例えばフェニルオキシカルボニル基等

が挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基等が挙げられる。)、

- [0039] アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 6、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノ基等が挙げら れる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは 炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニ ルアミノ基等が挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニルア ミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等が挙げられる。)、スルファモイル基(好ましくは 炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12であり、例 えばスルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル スルファモイル基等が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より 好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカルバモイル 基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等が 挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~ 16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等が挙 げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16 、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルチオ基等が挙げられる。)、
- [0040] スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル基、トシル基等が挙げられる。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基等が挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基等が挙げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、

WO 2005/097756 24 PCT/JP2005/006605

特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基等が挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、シリル基(好ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは炭素数3~24であり、例えばトリメチルシリル基、トリフェニルシリル基等が挙げられる。)などが挙げられる。これらの置換基はさらに置換されてもよい。また置換基が二つ以上ある場合は、同一でも異なっていてもよい。また、可能な場合には互いに連結して環を形成していてもよい

- [0041] R³、R³およびR¹⁰の無置換のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、1ープロピルオキシ基、2ープロピルオキシ基、1ーブチルオキシ基、2ーブチルオキシ基、se cーブチルオキシ基、tertーブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基、ドデシルオキシ基、2ーエチルヘキシルオキシ基、3,7ージメチルオクチルオキシ基、シクロプロピルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、1ーアダマンチルオキシ基、2ーアダマンチルオキシ基、ノルボルニルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ベンジロキシ基、α,αージメチルベンジロキシ基、2ーフェニルエトキシ基、1ーフェニルエトキシなどが挙げられる。
- [0042] 上記アルコキシ基は置換基を有してもよく、置換基としては、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばビニル基、アリル基、2-ブテニル基、3-ペンテニル基等が挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばプロパルギル、3-ペンチニル基等が挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル基、p-メチルフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~12、特に好ましくは炭素数0~6であり、例えばアミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジベンジルアミノ基等が挙げられる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~21

WO 2005/097756 25 PCT/JP2005/006605

2であり、例えばフェニルオキシ基、2ーナフチルオキシ基等が挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基等が挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル基等が挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~10であり、例えばフェニルオキシカルボニル等が挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ基、ベンゾイルオキシ基等が挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基等が挙げられる。)、

[0043] アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 6、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノ基等が挙げら れる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは 炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニ ルアミノ基等が挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニルア ミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等が挙げられる。)、スルファモイル基(好ましくは 炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12であり、例 えばスルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル スルファモイル基等が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より 好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカルバモイル 基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等が 挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~ 16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等が挙 げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16 、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニルチオ基等が挙げられる。)、

- [0044] スルホニル基(好ましくは炭素数 $1\sim20$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、特に好ましく は炭素数1~12であり、例えばメシル基、トシル基等が挙げられる。)、スルフィニル 基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばメタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基等が挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは 炭素数1~12であり、例えばウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基等が挙 げられる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸 アミド基等が挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素 原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニト ロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素 原子、酸素原子、硫黄原子を含むものであり、具体的には例えばイミダゾリル基、ピリ ジル基、キノリル基、フリル基、チエニル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキ サゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、カルバゾリル基等が挙げられ る。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましく は炭素数3~24であり、例えばトリメチルシリル基、トリフェニルシリル基等が挙げられ る。)などが挙げられる。これらの置換基はさらに置換されてもよい。また置換基が二 つ以上ある場合は、同一でも異なっていてもよい。また、可能な場合には互いに連結 して環を形成していてもよい。
- [0045] Ar¹~Ar³のアリーレン基とは、2価の芳香族基であり、例えば、フェニレン基、ナフチレン基、アントリレン基、ビフェニレン基、ターフェニレン基、ピレニレン基、クリセニレン基、フルオレニレン基、スピロフルオレニレン基等が挙げられ、好ましくはフェニレン基である。アリーレン基は置換基を有してもよく、上記アリール基の置換基の例として挙げたものが適用できる。

ヘテロアリーレン基とは、2価の複素環基であり、例えば、チオフェン環、フラン環、 セレノフェン環、ピリジン環、ピラジン環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、オ キサゾール環、チアゾール環、トリアゾール環等からなる二価基が挙げられる。好まし くは、チオフェン環、ピリジン環、オキサジアゾール環、トリアゾール環である。ヘテロアリーレン基は置換基を有してもよく、ヘテロアリール基の置換基の例として挙げたものが適用できる。

Ar¹~Ar³の2価の脂肪族炭化水素基として例えば、メチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ビニレン基、エチニレン基等が挙げられる。好ましくはメチレン基である。2 価の脂肪族炭化水素基は置換基を有してもよく、脂肪族炭化水素基の置換基の例として挙げたものが適用できる。

上記一般式(1-I)~(5-II)で表される含窒素複素環誘導体の具体例を以下に示すが、これら例示に限定されるものではない。

[0046] [化17]

[0047] [化18]

[0048] [化19]

[0049] [化20]

[0050] [化21]

[0051] [化22]

[0052] [化23]

[0053] [化24]

[0054] [化25]

[0055] [化26]

[0056] [化27]

[0057] [化28]

[0058] [化29]

1-84

1-85

[0060] [化31]

[0061] [化32]

[0062] [化33]

2-19

[0063] [化34]

[0064] [化35]

[0065] [化36]

[0066] [化37]

[0067] [化38]

[0068] [化39]

[0069] [化40]

[0070] [化41]

[0071] [化42]

[0072] [化43]

[0073] [化44]

[0074] [化45]

[0075] [化46]

[0077] [化48]

[0078] [化49]

$$CH_3$$
 H_3C
 H_3C

[0079] [化50]

[0080] [化51]

[0081] [化52]

[0082] [化53]

4-38

[0085] [化56]

[0086] [化57]

[0087] [化58]

[0088] [化59]

[0089] [化60]

[0090] [化61]

[0091] 本発明の有機EL素子は、有機化合物層の少なくとも一層が、上記一般式(A-1) または(A-2)、好ましくは上記一般式(1-I)~(5-II)で表される含窒素複素環誘導体を含有するものであって、その素子構成は、陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層または複数層からなる有機薄膜層が挟持されている構成である。具体的には、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/発光層/陰極)などが挙げられる。

本発明の含窒素複素環誘導体は、発光帯域に含有されることが好ましく、発光層に含有されることがより好ましく、さらに、電子注入層および/または電子注入層に含有されることが好ましい。素子構成においては、正孔注入層や電子注入層は無くてもよいが、本発明の含窒素複素環誘導体を含有するこれらの層を有する有機EL素子は発光性能が向上する利点がある。また、一対の電極間に上記正孔注入層、発光層および電子注入層を混合させた形で挟持させてもよい。さらに、各成分を安定に存在させるため、高分子化合物などのバインダーを用いて混合層を作製してもよい。

[0092] ここで、本発明の有機EL素子として、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層

/陰極)型を例として説明する。本発明の有機EL素子は、基板に支持されていることが好ましい。この基板については、特に制限はなく、従来の有機EL素子に慣用されているものであればよく、例えばガラス、透明プラスチック、英などからなるものを用いることができる。

本発明の有機EL素子における正極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物およびこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としてはAu等の金属、CuI, ITO, SnO_2 , ZnO等の導電性透明材料が挙げられる。この正極は、これらの電極物質を、蒸着やスパッタリングなどの薄膜化法により成膜して形成することができる。この電極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は 500Ω /□以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよるが、通常10nm~ 1μ m程度、好ましくは10~200nmの範囲で選ばれる。

- [0093] 一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4eV未満)金属,合金,電気伝導性化合物およびこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金,マグネシウム,マグネシウムー銀合金,リチウム,マグネシウム/銅混合物,マグネシウムーインジウム合金,Al/Al。O3,インジウム、アルミニウムーリチウム合金などが挙げられる。この陰極は、これらの電極物質を、蒸着やスパッタリングなどの薄膜化法により成膜して形成することができる。また、電極としてのシート抵抗は500 Q/□以下が好ましく、膜厚は通常10~500nm,好ましくは50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透過させるため、有機EL素子の陽極または陰極のいずれか一方が、透明または半透明であると、発光効率が向上し好都合である。
- [0094] 本発明の素子における発光層の発光材料としては、本発明の含窒素複素環誘導体を用いることが好ましい。この含窒素複素環誘導体が発光層以外で用いられている場合は、発光層の発光材料について、特に制限されることはなく、従来公知の化合物の中から任意のものから選択して用いることができる。この発光材料としては、例えば、多環縮合芳香族化合物、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキサノイド化合物、ジスチリルベン

ゼン系化合物など薄膜形成性の良い化合物を用いることができる。

ここで、上記多環縮合芳香族化合物としては、例えばアントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレン骨格を含む縮合環発光物質などを挙げることができる。具体的には、1,1,4,4ーテトラフェニルー1,3ーブタジエン;4,4'ー(2,2ージフェニルビニル)ビフェニルなどを用いることができる。この発光層は、これらの発光材料一種または二種以上からなる一層で構成されてもよいし、あるいはこの発光層とは別種の化合物を含む発光層を積層したものであってもよい。

[0095] 次に、本発明の有機EL素子における正孔注入層は、正孔伝達化合物からなるものであって、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入層を陽極と発光層の間に介在させることにより、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入される。その上、発光層に陰極または電子注入層より注入された電子は、発光層と正孔注入層の界面に存在する電子の障壁により、発光層内の界面に累積され発光効率が向上するなど発光性能の優れた素子となる。このような正孔注入層に用いられる正孔伝達化合物は、電界を与えられた2電極間に配置されて陽極から正孔が注入された場合、正孔を適切に発光層へ伝達し得るものであり、例えば10⁴~10⁶V/cmの電界印加時に少なくとも10⁶cm²/V・秒の正孔移動度を有するものが好適である。この正孔伝達化合物については、上記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやEL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

上記正孔伝達化合物としては、例えば、銅フタロシアニンや、N, N, N', N'ーテトラフェニルー4, 4'ージアミノフェニル; N, N'ージフェニルーN, N'ージ(3ーメチルフェニル)ー4, 4'ージアミノビフェニル(TPDA); 2, 2ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)プロパン; 1, 1ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)シクロヘキサン; N, N', N'ーテトラーpートリルー4, 4'ージアミノビフェニルなどが挙げられる。また、Si, SiC, CdSなどの無機物半導体の結晶, 非晶材料も用いることができる。この正孔注入層は、これらの正孔注入材料一種または二種以上からなる一層で構成されてもよいし、あるいは、上記正孔注入層とは別種の化合物からなる正孔注入層を積

WO 2005/097756 59 PCT/JP2005/006605

層したものであってもよい。

[0096] また、本発明の有機EL素子における電子注入層は、電子注入材料からなるものであって、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有している。本発明の有機EL素子では、上記一般式(A-1)、(A-2)、(1-I)~(5-II)で表される含窒素複素環誘導体が好ましい。この含窒素複素環誘導体が、電子注入層以外で用いられている場合は、電子注入材料について特に制限されることはなく、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。例えば、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチアゾール系化合物などが挙げられる。

本発明有機EL素子の好ましい形態として、電子を輸送する領域または陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子が挙げられる。本発明では、好ましくは上記一般式(A-1)、(A-2)、(1-I)~(5-II)で表される含窒素複素環誘導体に加え、還元性ドーパントを含有する素子が挙げられる。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元することができる物質と定義される。したがって、一定の還元性を有するものであれば、様々なものが用いられ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ金属の内ロゲン化物、希土類金属の酸化物または希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体、希土類金属の有機錯体がらなる群から選択される少なくとも一つの物質を好適に使用することができる。

[0097] 好ましい還元性ドーパントとしてより具体的には、Na(仕事関数:2.36eV)、K(仕事関数:2.28eV)、Rb(仕事関数:2.16eV)およびCs(仕事関数:1.95eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属や、Ca(仕事関数:2.9eV)、Sr(仕事関数:2.0~2.5eV)、およびBa(仕事関数:2.52eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属が挙げられ、仕事関数が2.9eV以下のものが特に好ましい。これらのうち、より好ましい還元性ドーパントは、K、RbおよびCsからなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属であり、さらに好ましくは、RbまたはCsであり、最も好ましくは、Csである。

これらのアルカリ金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。また、仕事関数が2.9eV以下の還元性ドーパントとして、これら2種以上のアルカリ金属の組み合わせも好ましく、特に、Csを含んだ組み合わせ、例えば、CsとNa、CsとK、CsとRbあるいはCsとNaとKとの組み合わせであることが好ましい。Csを組み合わせて含むことにより、還元能力を効率的に発揮することができ、電子注入域への添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。またアルカリ金属の他にアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用しても同様の効果が得られ、アルカリ金属有機錯体、アルカリ土類金属有機錯体を用いても同様の効果が得られる。

[0098] 本発明においては陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けてもよい。電子注入層を設けることにより、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層をこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成することにより、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。

好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとして具体的には、例えば、Li₂O、LiO、Na₂S、Na₂SeおよびNaOが挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、およびCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiCl、KClおよびNaCl等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、CaF₂、BaF₂、SrF₂、MgF₂およびBeF₂といったフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

また、上記半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、SbおよびZnの少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物または酸化窒化物等の一種単独または二種以上の組み合わせが挙げられる。これらの無機化合物は、

微結晶または非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子注入層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

- [0099] 本発明の有機EL素子における電子注入層は、本発明の含窒素複素環誘導体を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の薄膜化法により成膜して形成することができる。電子注入層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm~5μm程度である。この電子注入層は、これらの電子注入材料一種または二種以上からなる一層で構成されてもよいし、あるいは、上記層とは別種の化合物からなる電子注入層を積層したものであってもよい。さらに無機物であるp型ーSi、p型ーSiCによる正孔注入材料、n型αーSi、n型αーSiCによる電子注入材料を電子注入材料として用いることができる。例えば、国際公開WO90/05998号公報に開示されている無機半導体などが挙げられる。
- [0100] 次に、本発明の有機EL素子を作製する好適な例を説明する。一例として、上記の (陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)の構成を有する有機EL素子の 作製法について説明すると、まず適当な基板上に、所望の電極物質、例えば陽極用 物質からなる薄膜を、1 μ m以下、好ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陽極を作製する。次に、この上に素子材料である正孔注入層、発光層、電子注入層の材料からなる薄膜を形成させる。この薄膜化の方法としては、上記の如くスピンコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくいなどの点から、真空蒸着法が好ましい。

薄膜化に蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用する化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般にボート加熱温度50~400℃、真空度 10^{-6} ~ 10^{-3} Pa、蒸着速度0.01~50nm/秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nm~5 μ mの範囲で適宜選ぶことが望ましい。これらの層の形成後、その上に陰極用物質からなる薄膜を、1 μ m以下好ましくは50~200nmの範囲

の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陰極を設けることにより、所望の有機EL素子が得られる。なお、この有機EL素子の作製においては、薄膜の形成順序を逆にして、陰極、電子注入層、発光層、正孔注入輸送層、陽極の順に薄膜を形成することもできる。

[0101] また、一対の電極間に正孔注入層、発光層、電子注入層を混合させた形で挟持させた陽極/発光層/陰極からなる素子の作製方法としては、例えば、適当な基板の上に、陽極用物質からなる薄膜を形成し、正孔注入材料、発光材料、電子注入材料、ポリビニルカルバゾール、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリエーテルなどの結着剤などからなる溶液を塗布するか、またはこの溶液から浸漬塗工法により薄膜を形成させて発光層とし、その上に陰極用物質からなる薄膜を形成させる方法が挙げられる。ここで、作製した発光層上に、さらに発光層や電子注入層の材料となる素子材料を真空蒸着し、その上に陰極用物質からなる薄膜を形成させてもよい

このようにして得られた有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+、陰極を-の極性として電圧3~50V程度を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れずに発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、正極が+、負極が-の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流電圧の波形は任意でよい。

実施例

[0102] 次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

[合成例1]

以下のようにして化合物1-1を合成した。

(1-a)2-ブロモアントラキノンの合成

臭化銅18g(81mmol)、亜硝酸tーブチル12mL(101mmol)を65℃のアセトニトリルに分散させ激しく攪拌させながら、2ーアミノアントラキノン15g(67mmol)を滴下した。ガスが完全に出なくなるまで攪拌し、室温まで冷却し、20質量%の塩酸1Lを加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を

減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2-ブロモアントラキノン14 g(収率75%)を得た。

(1-b)2-ブロモー9, 10-ジフェニルー9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセンー 9, 10-ジオールの合成

アルゴン雰囲気下、ブロモベンゼン5. 4mL(52mmol)を脱水THF(テトラヒドロフラン)100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、t-ブチルリチウム45mL(ペンタン中、1. 5mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、2-ブロモアントラキノン4. 9g(17mmol)を加えた。塩化アンモニウム水溶液を加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去した。得られた個体をエタノールで洗浄し、2-ブロモー9、10-ジフェニルー9、9、10、10-テトラヒドロアントラセンー9、10-ジオール6. 8g(収率90%)を得た。

[0103] (1-c)2-ブロモー9, 10-ジフェニルアントラセンの合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモー9、10ージフェニルー9、9、10、10ーテトラヒドロアントラセンー9、10ージオール4.5g(10mmol)を酢酸に溶解させ、ヨウ化カリウム17g(102mmol)、NaH2PO218g(167mmol)を加え、3時間激しく攪拌させながら加熱還流させた。室温まで冷却し、ろ過した。得られた個体を水、メタノールで洗浄後、減圧乾燥させ2ーブロモー9、10ージフェニルアントラセン3.5g(収率85%)を得た。

(1-d)9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモー9、10ージフェニルアントラセン3. 5g(8.6mmol)に脱水THF50mLを加え、-78℃まで冷却し、nーブチルリチウム6.0mL(ヘキサン中、1.6mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、0℃まで昇温させた。再び-78℃まで冷却し、トリメトキシボラン2.9mL(26mmol)を滴下した。-78℃で1時間攪拌後、室温で2時間攪拌した。10質量%塩酸50mLを加え、1時間攪拌後ろ過した。得られた個体をトルエンで洗浄し、9、10ージフェニルアントラセン-2ーボロン酸2.6g(収率80%)を得た。

(1-e)4-ブロモ-2-ニトロジフェニルアミンの合成

2, 5-ジブロモニトロベンゼン10g(36mmol)、酢酸ナトリウム8. 8g(110mmol)、

アニリン6. 6g(71mmol)をアルゴン雰囲気下、160℃で9時間加熱攪拌した。反応溶液を室温まで冷却し、酢酸エチルと水を用いて抽出した。水層を除去した後、有機層を10質量%塩酸、10質量%炭酸カリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、4ーブロモー2ーニトロジフェニルアミン9. 9g(収率95%)を得た。

[0104] (1-f)5-ブロモ-2-(N-フェニルアミノ)-ベンズアニリドの合成

4ーブロモー2ーニトロジフェニルアミン9.9g(34mmol)をテトラヒドロフラン75mLに溶解させ、窒素雰囲気下、これを室温で攪拌しながら、ハイドロサルファイトナトリウム30g(170mmol)/水100mLの溶液を加えた。さらにメタノール10mLを加えて3時間攪拌した。次に酢酸エチル75mLを加え、炭酸水素ナトリウム5.7g(68mmol)/水60mLの溶液を加えた。さらにベンゾイルクロリド4.8g(34mmol)/酢酸エチル25mLの溶液を加えた。さらにベンゾイルクロリド4.8g(34mmol)/酢酸エチル25mLの溶液を滴下し、室温で5時間攪拌した。酢酸エチルで抽出し、10質量%炭酸カリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去し、5ーブロモー2ー(Nーフェニルアミノ)ーベンズアニリド5.6g(収率45%)を得た。

(1-g)5-ブロモー1,2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾールの合成 5-ブロモー2-(N-フェニルアミノ)ベンズアニリド5.6g(15mmol)をキシレン60 mL中に懸濁させ、p-トルエンスルホン酸1水和物0.88g(4.6mmol)を加え、5時 間加熱還流させながら共沸脱水を行った。反応溶液を室温まで冷却し溶媒留去した 。得られた固体をエタノールで洗浄し、5-ブロモー1,2-ジフェニルー1H-ベンズ イミダゾール2.5g(収率46%)を得た。

[0105] (1-h)5-(4-クロロフェニル)-1, 2-ジフェニル-1H-ベンズイミダゾールの合成

5ーブロモー1, 2ージフェニルー1Hーベンズイミダゾール2. 5g(7. 2mmol)、4ークロロフェニルボロン酸1. 2g(7. 9mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0. 17g(0. 14mmol)を1, 2ージメトキシエタン20mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、水層を除去し、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去後、得られた固

体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、5-(4-クロロフェニル)-1, 2-ジフェニル-1H-ベンズイミダゾール2. 3g(収率83%)を得た。

(1-i)1,2-ジフェニル-5-[4-(9,10-ジフェニルアントラセン-2-イル)フェニル]-1H-ベンズイミダゾールの合成

5-(4-クロロフェニル)-1, 2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾール2. 3g(6. 0mmol)、9, 10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸2. 5g(6. 6mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)(0. 14g, 0. 15mmol)、炭酸セシウム(4. 7g, 14mmol)を無水ジオキサン20mLに懸濁し、トリシクロヘキシルホスフィン/トルエン溶液(25質量%, 0. 49ml, 0. 43mmol)を加えて80℃で10時間攪拌した。反応混合物をトルエン200mL+水100mLで希釈し、Celite545でろ別してPd黒を除いた。ろ液から有機層を分取し、飽和食塩水50mLで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒留去して赤色オイルを得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、3. 0g(収率75%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量674. 27に対し、m/e=674であった。

[0106] [合成例2]

以下のようにして化合物1-2を合成した。

(2-a)2-ブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル) -9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセンー9, 10-ジオールの合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモナフタレン11g(53mmol)を脱水THF100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、tーブチルリチウム45mL(ペンタン中、1.5mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、2ーブロモアントラキノン6.3g(22mmol)を加えた。塩化アンモニウム水溶液を加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去した。得られた個体をエタノールで洗浄し、2ーブロモー9、10ージ(2ーナフチル)ー9、9、10、10ーテトラヒドロアントラセンー9、10ージオール11g(収率94%)を得た。

(2-b) 2-ブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

アルゴン雰囲気下、2-ブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル)-9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセン-9, 10-ジオール11g(21mmol)を酢酸に溶解させ、ヨウ化カ

リウム34g(206mmol)、 $NaH_2PO_36g(340mmol)$ を加え、3時間激しく攪拌させながら加熱還流させた。室温まで冷却し、ろ過した。得られた個体を水、メタノールで洗浄後、減圧乾燥させ2ーブロモー9、10-ジフェニルアントラセン10g(収率96%)を得た。

[0107] (2-c)9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸の合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモー9、10ージ(2ーナフチル)アントラセン10g(20m mol)に脱水THF 100mLを加え、-78℃まで冷却し、nーブチルリチウム14mL(1 . 6M in hexane)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、0℃まで昇温させた。再び-78℃まで冷却し、トリメトキシボラン6.6mL(60mmol)を滴下した。-78℃で1時間攪拌後、室温で2時間攪拌した。10質量%塩酸100mLを加え、1時間攪拌後ろ過した。得られた個体をトルエンで洗浄し、9、10ージフェニルアントラセンー2ーボロン酸4.7g(収率50%)を得た。

(2-d)1, 2-ジフェニル-5-[4-[9, 10-ジ(2-ナフチル)フェニルアントラセ ン-2-イル]フェニル]-1H-ベンズイミダゾールの合成

5-(4-クロロフェニル)-1, 2-ジフェニル-1H-ベンズイミダゾール2. 3g(6. 0mmol)、9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸3. 1g(6. 6mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)(0. 14g, 0. 15mmol)、炭酸セシウム(4. 7g, 14mmol)を無水ジオキサン20mLに懸濁し、トリシクロヘキシルホスフィン/トルエン溶液(25質量%, 0. 49ml, 0. 43mmol)を加えて80℃で10時間攪拌した。反応混合物をトルエン200mL+水100mLで希釈し、Celite545でろ別してPd黒を除いた。ろ液から有機層を分取し、飽和食塩水50mLで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒留去して赤色オイルを得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、3. 2g(収率69%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量774. 30に対し、m/e=774であった。

[0108] [合成例3]

以下のようにして化合物1-9を合成した。

(3-a)4-ブロモ-N-メチル-2-ニトロアニリンの合成

N-メチル-2-ニトロアニリン5. Og(33mmol)、N-ブロモスクシンイミド5. 9g(3

3mmol)、に酢酸60mLを加え、7時間加熱還流を行った。反応終了後、反応溶液を水500mLに注ぎ、析出した固体をろ別した。ろ別した固体を酢酸エチルに溶解させ、硫酸マグネシウムで乾燥させた。ろ過後、溶媒を減圧留去し、室温で減圧乾燥後、4ーブロモーNーメチルー2ーニトロアニリンの橙色固体7.1g(収率93%)を得た。

(3-b)4'-ブロモ-N-メチル-2'-ニトローベンズアニリドの合成

4ーブロモーNーメチルー2ーニトロアニリン6.8g(29mmol)をピリジン20mLに溶解させ、さらにベンゾイルクロライド5.0g(35mmol)を加え、アルゴン雰囲気下、90℃で7時間加熱攪拌した。反応終了後、酢酸エチル200mLを加え、10質量%塩酸、10質量%K2CO、飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥させた。ろ過後、溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、4'ーブロモーNーメチルー2'ーニトローベンズアニリドを緑白色固体9.5g(収率96%)として得た。

(3-c)4'-ブロモ-N-メチル-2'-アミノ-ベンズアニリドの合成

4'ーブロモーNーメチルー2'ーニトローアセトアニリド9.5g(28mmol)をテトラヒドロフラン100mLに溶解させ、アルゴン雰囲気下、これを室温で攪拌しながら、ハイドロサルファイトナトリウム25g(142mmol)/水90mLの溶液を加えた。さらにメタノール10mLを加えて3時間攪拌した。次に酢酸エチル100mLを加え、炭酸水素ナトリウム12g(142mmol)/水125mLの溶液を加えた。1時間攪拌後、酢酸エチルで抽出した。水層を除去し、有機層を10質量%K₂CO₃水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去させ、4'ーブロモーNーメチルー2'ーアミノーベンズアニリドを白色固体7.8g(収率90%)として得た。粗生成物のまま次の反応に用いた。

[0109] (3-d)5-ブロモー1-メチルー2-フェニルー1H-ベンズイミダゾールの合成 4'-ブロモーN-メチルー2'-アミノーベンズアニリド7.8g(26mmol)をキシレン 50mL中に懸濁させ、pートルエンスルホン酸1水和物1.5g(7.7mmol)を加え、7 時間加熱還流させた。反応終了後ろ過した。得られた固体を塩化メチレンに溶解させ、10質量%K₂CO₂、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減

圧留去した。ろ液は、10質量% K_{2} CO $_{3}$ 、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた2つの残渣を合一し、シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、5-ブロモー1-メチルー2-フェニルー1H-ベンズイミダゾールを白色固体6. 5g(収率89%)として得た。

(3-e)5-(4-クロロフェニル)-1-メチル-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾ ールの合成

5ーブロモー1ーメチルー2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾール2. 0g(7. 2mmo l)、4ークロロフェニルボロン酸1. 2g(7. 9mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0. 17g(0. 14mmol)を1, 2ージメトキシエタン20mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、水層を除去し、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去後、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、5ー(4ークロロフェニル)ー1,2ージフェニルー1Hーベンズイミダゾール2. 0g(収率87%)を得た。

(3-f)5-[4-(9,10-ジフェニルアントラセン-2-イル)フェニル]-1-メチル -2-フェニル-1H-ベンズイミダゾールの合成

5-(4-クロロフェニル)-1, 2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾール1. 9g(6. 0mmol)、9, 10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸2. 5g(6. 6mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)(0. 14g, 0. 15mmol)、炭酸セシウム(4. 7g, 14mmol)を無水ジオキサン20mLに懸濁し、トリシクロヘキシルホスフィン/トルエン溶液(25質量%, 0. 49ml, 0. 43mmol)を加えて80℃で10時間攪拌した。反応混合物をトルエン200mL+水100mLで希釈し、Celite545でろ別してPd黒を除いた。ろ液から有機層を分取し、飽和食塩水50mLで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒留去して赤色オイルを得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、3. 2g(収率87%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量612. 26に対し、m/e=612であった。

[0110] 「合成例4]

以下のようにして化合物1-41を合成した。 (4-a)2-ブロモアントラキノンの合成 臭化銅18g(81mmol)、亜硝酸tーブチル12mL(101mmol)を65℃のアセトニトリルに分散させ激しく攪拌させながら、2ーアミノアントラキノン15g(67mmol)を滴下した。ガスが完全に出なくなるまで攪拌し、室温まで冷却し、20質量%の塩酸1Lを加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2ーブロモアントラキノン14g(収率75%)を得た。

(4-b)2-ブロモー9, 10-ジフェニルー9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセンー 9, 10-ジオールの合成

アルゴン雰囲気下、ブロモベンゼン5. 4mL(52mmol)を脱水THF(テトラヒドロフラン)100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、tーブチルリチウム45mL(ペンタン中、1.5mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、2ーブロモアントラキノン4.9g(17mmol)を加えた。塩化アンモニウム水溶液を加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去した。得られた個体をエタノールで洗浄し、2ーブロモー9、10ージフェニルー9、9、10、10ーテトラヒドロアントラセンー9、10ージオール6.8g(収率90%)を得た。

[0111] (4-c)2-ブロモー9, 10-ジフェニルアントラセンの合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモー9, 10ージフェニルー9, 9, 10, 10ーテトラヒドロアントラセンー9, 10ージオール4. 5g(10 mmol)を酢酸に溶解させ、3ウ化カリウム17g(102 mmol)、 NaH_2PO_2 18g(167 mmol)を加え、3時間激しく攪拌させながら加熱還流させた。室温まで冷却し、ろ過した。得られた個体を水、3クノールで洗浄後、減圧乾燥させ2-ブロモー9, 10-ジフェニルアントラセン3. 5g(収率85%)を得た。

(4-d)9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモー9、10ージフェニルアントラセン3. 5g(8.6mmol)に脱水THF50mLを加え、-78℃まで冷却し、nーブチルリチウム6.0mL(ヘキサン中、1.6mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、0℃まで昇温させた。 再び-78℃まで冷却し、トリメトキシボラン2.9mL(26mmol)を滴下した。-78℃で1時間攪拌後、室温で2時間攪拌した。10質量%塩酸50mLを加え、1時間攪拌後 ろ過した。得られた個体をトルエンで洗浄し、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸2.6g(収率80%)を得た。

2-ブロモニトロベンゼン10g(50 mmol)、酢酸ナトリウム13g(163 mmol)、4-ブ

[0112] (4-e)4-ブロモ-2'ーニトロジフェニルアミンの合成

ロモアニリン10g(59mmol)をアルゴン雰囲気下180℃で8時間加熱攪拌した。反応溶液を室温まで冷却し、酢酸エチルで希釈し、ろ過した。ろ液を濃縮後、残渣をメタノールで洗浄し、4ーブロモー2'ーニトロジフェニルアミン3.8g(収率22%)を得た。(4ーf)Nー[2ー(4ーブロモフェニルアミノ)フェニル]ベンズアミドの合成4ーブロモー2'ーニトロジフェニルアミン3.8g(13mmol)をTHF30mLに溶解させ、アルゴン雰囲気下、室温においてこれを攪拌しながら、ハイドロサルファイトナトリウム11g(64mmol)/水30mLの溶液を滴下した。5時間攪拌した後、酢酸エチル20mLを加えて、炭酸水素ナトリウム2.2g(26mmol)/水20mLの溶液を滴下し、空温で1時間攪拌した。酢酸エチルで抽出し、10質量%炭酸カリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去し、Nー[2ー

[0113] (4-g)1-(4-ブロモフェニル)-2-フェニルー1H-ベンズイミダゾールの合成 N-[2-(4-ブロモフェニルアミノ)フェニル]ベンズアミド2. 1g(5. 7mmol)をキシレン30mL中に懸濁させ、p-トルエンスルホン酸1水和物0. 6g(2. 9mmol)を加え、3時間加熱還流させた。放冷後、反応溶液に酢酸エチル、ジクロロメタン、水を加え、不溶物をろ別した。母液から有機層を抽出し、水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、1-(4-ブロモフェニル)-2-フェニルー1H-ベンズイミダゾール1. 0g(収率52%)を得た。

(4ーブロモフェニルアミノ)フェニル]ベンズアミド2.1g(収率45%)を得た。

(4-h)1-[4-(9, 10-ジフェニルアントラセン-2-イル)フェニル]-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾールの合成

1-(4-)ブロモフェニル)-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール1.0g(2.9m mol)、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸1.2g(3.2mmol)、テトラキス

(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.067g(0.058mmol)を1,2ージメトキシエタン20mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、1.6g(収率90%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量598.24に対し、m/e=598であった。

[0114] 「合成例5]

以下のようにして化合物1-42を合成した。

(5-a)1-[4-[9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-イル]フェニル]-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾールの合成

1-(4-ブロモフェニル)-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール1.0g(2.9m mol)、9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸1.5g(3.2mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.067g(0.058mmol)を1,2-ジメトキシエタン20mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、1.7g(収率84%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量698.27に対し、m/e=698であった。

[0115] 「合成例6]

化合物1-41の合成工程(4-b)において、ブロモベンゼンの代わりに2-ブロモ-3,5-ジフェニルベンゼンを用いた以外は、同様にして化合物1-43を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量902.37に対し、m/e=902であった。

[合成例7]

化合物1-41の合成工程(4-b)において、ブロモベンゼンの代わりに2-ブロモビフェニルを用いた以外は、同様にして化合物1-44を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量750.30に対し、m/e=750であった。

「合成例8〕

化合物1-41の合成工程(4-b)において、ブロモベンゼンの代わりに1-ブロモ

ナフタレンを用いた以外は、同様にして化合物1-45を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量698.27に対し、m/e=698であった。

[0116] [合成例9]

以下のようにして化合物2-2を合成した。

(9-a)2,6-ジブロモアントラキノンの合成

2,6ージアミノアントラキノン23.8g(100mmol)を48質量%臭化水素水溶液に分散させ、亜硝酸ナトリウム14.1g(204mmol)を加えた。完全にガスが出なくなった後、臭化銅30g(206mmol)/48質量%臭化水素水溶液63mLをエタノール50m Lとともに滴下した。反応溶液を徐々に加熱し、加熱還流を行った。室温まで放冷し、水を加えた。析出した固体をろ別し、水で洗浄した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2,6ージブロモアントラキノン10.0g(収率27%)を得た。(9ーb)2,6ージブロモー9,10ージ(2ーナフチル)ー9,9,10,10ーテトラヒドロアントラセンー9,10ージオールの合成

アルゴン雰囲気下、2ーブロモナフタレン11g(53mmol)を脱水THF100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、tーブチルリチウム45mL(ペンタン中、1.5mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、2,6ージブロモアントラキノン8.1g(22mmol)を加えた。塩化アンモニウム水溶液を加えた後、ジクロロメタンで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧留去した。得られた固体をエタノールで洗浄し、2,6ージブロモー9,10ージ(2ーナフチル)ー9,9,10,10ーテトラヒドロアントラセンー9,10ージオール12g(収率90%)を得た。

[0117] (9-c) 2, 6-ジブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成 アルゴン雰囲気下、2, 6-ジブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル)ー9, 9, 10, 10-テトラヒドロアントラセンー9, 10-ジオール12g(19mmol)を酢酸に溶解させ、ヨウ 化カリウム31g (186mmol)、NaH PO 33g(307mmol)を加え、3時間激しく攪拌 させながら加熱還流させた。室温まで冷却し、ろ過した。得られた個体を水、メタノールで洗浄後、減圧乾燥させ2-ブロモー9, 10-ジフェニルアントラセン10g(収率8 9%)を得た。

(9-d)2, 6-ビス(4-クロロフェニル)-9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

2ーブロモー9, 10ージフェニルアントラセン5. 0g(8.5mmol)、4ークロロフェニルボロン酸2. 9g(18.7mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0. 20g(0.17mmol)を1, 2ージメトキシエタン50mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液25mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2, 6ービス(4ークロロフェニル)ー9, 10ージ(2ーナフチル)アントラセン4. 8g(収率86%)を得た。

[0118] (9-e)1, 2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾールー5-ボロン酸の合成 5-ブロモー1, 2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾール10g(29mmol)をアルゴン雰囲気下、脱水THF100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、n-ブチルリチウム20mL(ヘキサン中、1.6mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、0℃まで昇温させた。再び-78℃まで冷却し、トリメトキシボラン9.7mL(87mmol)を滴下した。-78℃で1時間攪拌後、室温で2時間攪拌した。10質量%塩酸100mLを加え、1時間攪拌後ろ過した。ろ液の有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、1,2-ジフェニルー1H-ベンズイミダゾールー5-ボロン酸3.2g(収率35%)を得た。

(9-f)2,6-ビス[4-(1,2-ジフェニル-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)-フェニル]-9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

2,6ービス(4ークロロフェニル) -9,10ージ(2ーナフチル)アントラセン2.0g(3.1mmol)、1,2ージフェニルー1Hーベンズイミダゾールー5ーボロン酸2.1g(6.8mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)(0.14g,0.16mmol)、炭酸セシウム(1.4g,7.44mmol)を無水ジオキサン20mLに懸濁し、トリシクロヘキシルホスフィン/トルエン溶液(25質量%,0.13ml,0.11mmol)を加えて80℃で10時間攪拌した。反応混合物をトルエン100mL+水50mLで希釈し、Celite545でろ別してPd黒を除いた。ろ液から有機層を分取し、飽和食塩水50mLで洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒留去して赤色オイルを得た。これをシリカゲルカラムク

ロマトグラフィで精製し、2.6g(収率82%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量1118.43に対し、m/e=1118であった。

[0119] [合成例10]

以下のようにして化合物2-12を合成した。

(10-a)4-(2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール-1-イル)フェニルボロン酸 の合成

1-(4-ブロモフェニル)-2-フェニルー1H-ベンズイミダゾール10g(29mmol)をアルゴン雰囲気下、脱水THF100mLに溶解させ、-78℃まで冷却し、n-ブチルリチウム20mL(ヘキサン中、1.6mol/L)を滴下した。-78℃で1時間攪拌した後、0℃まで昇温させた。再び-78℃まで冷却し、トリメトキシボラン9.7mL(87mm ol)を滴下した。-78℃で1時間攪拌後、室温で2時間攪拌した。10質量%塩酸100mLを加え、1時間攪拌後ろ過した。ろ液の有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、4-(2-フェニルー1H-ベンズイミダゾールー1-イル)フェニルボロン酸4.2g(46%)を得た。

(10-b)2, 6-ビス[4-(2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール-1-イル)フェニル]-9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

2,6ージブロモー9,10ージ(2ーナフチル)アントラセン2.0g(3.4mmol)、4ー(2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾールー1ーイル)フェニルボロン酸2.4g(7.5mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.16g(0.14mmol)を1,2ージメトキシエタン30mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液15mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2.4g(収率73%)の緑白色結晶を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量966.37に対し、m/e=966であった。

[0120] 「合成例11]

以下のようにして化合物3-2を合成した。

(11-a)1, 2-ジフェニル-5-[9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-イル]-1H-ベンズイミダゾールの合成

5ーブロモー1, 2ージフェニルー1Hーベンズイミダゾール1. 7g(4.9mmol)、9, 10ージ(2ーナフチル)アントラセンー2ーボロン酸2. 5g(5.3mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0. 11g(0.097mmol)を1, 2ージメトキシエタン20m Lに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2. 1g(収率61%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量698. 27に対し、m/e=698であった。

[0121] [合成例12]

化合物3-2の合成において、9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ジ(1-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-3を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量698.27に対し、m/e=698であった。

「合成例13]

化合物3-2の合成において、9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ビス(3,5-ジフェニルフェニル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-4を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量902.37に対し、m/e=902であった。

「合成例14〕

化合物3-2の合成において、9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ビス(ビフェニル-2-イル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-5を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量750.30に対し、m/e=750であった。

[0122] [合成例15]

以下のようにして化合物3-9を合成した。

(15-a)5-(9,10-ジフェニルアントラセン-2-イル)-1-メチル-2-フェニル-1H-ベンズイミダゾールの合成

5ーブロモー1ーメチルー2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾール1. 4g(4.9mmo l)、9,10ージフェニルアントラセンー2ーボロン酸2.0g(5.3mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.11g(0.097mmol)を1,2ージメトキシエタン20m Lに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液10mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2.0g(収率76%)の緑白色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量536.23に対し、m/e=536であった。

[0123] 「合成例16]

以下のようにして化合物3-46を合成した。

(16-a)9, 10-ジ(2-ナフチル)-2-(2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール-1-イル)アントラセンの合成

2ーブロモー9, 10ージ(2ーナフチル)アントラセン5. 1g(10mmol)、2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾール2. 3g(12mmol)、ヨウ化銅0. 19g(1. 0mmol)、9, 10ーフェナントロリン3. 6g(2. 0mmol)を2M炭酸セシウム/DMF(ジメチルホルムアミド)溶液に溶解させ、アルゴン雰囲気下、48時間加熱環流した。反応終了後、ろ過した。ろ液を10質量%塩酸1Lに注ぎ、塩化メチレンで抽出した。有機層を取り出し、硫酸マグネシウムで乾燥させた後、溶媒を減圧留去した。得られた個体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2. 2g(収率35%)の淡黄色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量622. 24に対し、m/e=622であった。

[0124] 「合成例17]

化合物3-9の合成において、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-74を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量636.26に対し、m/e=636であった。

「合成例18〕

化合物3-9の合成において、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ジ(1-ナフチル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様に

して化合物3-75を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量636.26に対し、m/e=636であった。

[合成例19]

化合物3-9の合成において、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ビス(ビフェニル-2-イル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-76を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量688.29に対し、m/e=688であった。

[合成例20]

化合物3-9の合成において、9,10-ジフェニルアントラセン-2-ボロン酸の代わりに9,10-ビス(3,5-ジフェニルフェニル)アントラセン-2-ボロン酸を用いた以外は、同様にして化合物3-77を合成した。このものはマススペクトルの分析の結果、目的物であり、分子量840.35に対し、m/e=840であった。

[0125] [合成例21]

以下のようにして化合物4-2を合成した。

(21-a)2, 6-ビス(1, 2-ジフェニル-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)-9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

2,6ージブロモー9,10ージ(2ーナフチル)アントラセン2.0g(3.4mmol)、1,2 ージフェニルー1Hーベンズイミダゾールー5ーボロン酸2.4g(7.5mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.16g(0.14mmol)を1,2ージメトキシエタン30mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液15mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2.4g(収率73%)の緑白色結晶を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量966.37に対し、m/e=966であった。

[0126] [合成例22]

以下のようにして化合物4-20を合成した。

(22-a)2,6-ビス(2-フェニルー1H-ベンズイミダゾールー1-イル)-9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセンの合成

2, 6-ジブロモ-9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン5. 9g(10 mmol)、2-フ

ェニルー1Hーベンズイミダゾール4.3g(22mmol)、ヨウ化銅0.38g(2.0mmol)、9,10ーフェナントロリン7.2g(4.0mmol)を2M炭酸セシウム/DMF溶液に溶解させ、アルゴン雰囲気下、48時間加熱還流した。反応終了後、ろ過した。ろ液を10質量%塩酸1Lに注ぎ、塩化メチレンで抽出した。有機層を取り出し、硫酸マグネシウムで乾燥させた後、溶媒を減圧留去した。得られた個体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2.5g(収率31%)の淡黄色固体を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目的物であり、分子量814.31に対し、m/e=814であった。

[0127] 「合成例23]

以下のようにして化合物5-24を合成した。

(23-a)2-ブロモー9, 10-ジ(2-ナフチル)-6-(2-フェニルー1H-ベンズ イミダゾールー1-イル)アントラセンの合成

2,6ージブロモー9,10ージ(2ーナフチル)アントラセン5.9g(10mmol)、2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾール2.2g(11mmol)、ヨウ化銅0.19g(1.0mmol)、9,10ーフェナントロリン3.6g(2.0mmol)を2M炭酸セシウム/DMF溶液に溶解させ、アルゴン雰囲気下、48時間加熱還流した。反応終了後、ろ過した。ろ液を10質量%塩酸1Lに注ぎ、塩化メチレンで抽出した。有機層を取り出し、硫酸マグネシウムで乾燥させた後、溶媒を減圧留去した。得られた個体をシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製し、2.5g(収率36%)の淡黄色固体を得た。

(23-b)9, 10-ジ(2-ナフチル)-2-(2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール-1-イル)-6-[4-(2-フェニル-1H-ベンズイミダゾール-1-イル)-フェニル]アントラセンの合成

2ーブロモー9, 10ージ(2ーナフチル)ー6ー(2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾールー1ーイル)アントラセン2. 5g(3.6mmol)、4ー(2ーフェニルー1Hーベンズイミダゾールー1ーイル)フェニルボロン酸1. 4g(4.3mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0. 16g(0.14mmol)を1, 2ージメトキシエタン30mLに溶解させ、2M炭酸ナトリウム水溶液15mLを加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。放冷後、反応終了後、ろ過し、得られた固体を水、メタノール、トルエンで洗浄し、2.4g(収率76%)の緑白色結晶を得た。このものは、マススペクトル分析の結果、目

的物であり、分子量890.34に対し、m/e=890であった。

[0128] [実施例1]

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を3の分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、上記透明電極を覆うようにして膜厚60nmのN, N'ービス(N, N'ージフェニルー4ーアミノフェニル)ーN, Nージフェニルー4, 4'ージアミノー1, 1'ービフェニル膜(以下「TPD232膜」と略記する。)を抵抗加熱蒸着により成膜した。このTPD232膜は、第一の正孔注入層(正孔輸送層)として機能する。TPD232膜の成膜に続けてこのTPD232膜上に膜厚20nmの4, 4'ービス[Nー(1ーナフチル)ーNーフェニルアミノ]ビフェニル膜(以下「NPD膜」と略記する。)を抵抗加熱蒸着により成膜した。このNPD膜は第2の正孔注入層(正孔輸送層)として機能する。さらに、NPD膜の成膜に続けてこのNPD膜上に膜厚40nmで4', 4"ービス(2, 2ージフェニルビニル)ー9, 10ージフェニルアントラセン(以下「DPVDPAN」と略記する。)を抵抗加熱蒸着により成膜した。このDPVDPAN膜は、発光層として機能する。

そしてDPVDPAN膜の成膜に続いて、このDPVDPAN膜上に化合物1-41を蒸着して膜厚10nmの化合物1-41膜を成膜した。この化合物1-41膜は、電子注入層として機能する。この後、Li(Li源:サエスゲッター社製)と化合物1-41を二元蒸着させ、電子注入層(または陰極)として化合物1-41:Li膜を成膜速度1.5Å/sec:1Å/minで膜厚10nm形成した。この化合物1-41:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を膜厚130nm形成し有機EL発光素子を形成した。

得られた有機EL発光素子について、表1に示す所定の直流電圧を印加した条件で、発光輝度および発光効率を測定した。その結果を表1に示す。

[0129] 「実施例2~7]

実施例1における化合物1-41の代わりに表1に示す化合物を用いて、同様の有機EL素子を作製し、同様の測定を行った。その結果を表1に示す。

「比較例1]

実施例1における化合物1-41の代わりに、下記式で表されるAlq(8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体)を用いて、同様の有機EL素子を作製し、同様の測定を行った。その結果を表1に示す。

[0130] [化62]

[0131] [比較例2]

実施例1における化合物1-41の代わりに、下記式で表されるUSP5, 645, 948 号明細書記載の化合物Aを用いて、同様の有機EL素子を作製し、同様の測定を行った。その結果を表1に示す。

[0132] [化63]

[0133] [比較例3]

実施例1における化合物1-41の代わりに、下記式で表される国際公開WO03/

060956号公報記載の化合物Bを用いて、同様の有機EL素子を作製し、同様の測定を行った。その結果を表1に示す。

[0134] [化64]

[0135] [比較例4]

実施例1における化合物1-41の代わりに、下記式で表される特開2002-0381 41号公報記載の化合物Cを用いて、同様の有機EL素子を作製した。

[0136] [化65]

[0137] [表1]

表1

	電子注入材料	電 圧 (V)	電流密度 (mA/cm2)		発光効率 (cd/A)
実施例1	化合物1-41	7.0	22	1466	6.7
実施例2	化合物1-42	7.0	22	1452	6.6
実施例3	化合物2-12	7.0	21	1365	6.5
実施例4	化合物3-2	7.0	20	1282	6.4
実施例5	化合物3-9	7.0	26	1846	7.1
実施例6	化合物4-2	7.0	20	1240	6.2
実施例7	化合物5-24	7.0	21	1344	6.4
比較例1	ALq	7.0	13	500	3.8
比較例2	化合物A	7.0	7.4	185	2.5
比較例3	化合物B	7.0	15	624	4.1
比較例4	化合物C	7.0	15	600	4.0

[0138] 上記表1の結果から、本発明の含窒素複素環誘導体を電子注入層として用いることで、高輝度、高発光効率の素子を製造できることがわかる。特に、比較例1,2の素子と比較すると、実施例の素子は2倍以上の効率を得ている。また、比較例3および4では、実施例で用いた化合物と類似の化合物を用いているが、発光輝度や発光効率は実施例の素子よりも低い。これに対して、実施例で用いた化合物では、ベンズイミダゾール部分とアントラセン核の結合様式が異なることにより、より電子注入性が高まり素子が低電圧化する上に効率が50%以上向上するという顕著な効果が確認された。中でも実施例5では、ベンズイミダゾール環へのアルキル基の導入は低電圧化、効率向上に特に効果的であることがわかる。

[0139] [実施例8~16]

実施例1における化合物1-41の代わりに表2に示す化合物を用いて、同様の有機EL素子を作製し、同様の測定を行った。その結果を表2に示す。

[0140] [表2]

表2

	電子注入材料	電圧 (V)	電流密度 (mA/cm2)	発光輝度 (nit)	発光効率 (cd/A)	
実施例8	化合物1-43	7.0	22	1462	6.6	
実施例9	化合物1-44	7.0	23	1450	6.3	
実施例10	化合物1-45	7.0	21	1365	6.5	
実施例11	化合物3-3	7.0	20	1246	6.2	
実施例12	化合物3-4	7.0	20	1246	6.2	
実施例13	化合物3-5	7.0	20	1286	6.4	
実施例14	化合物3-75	7.0	26	1846	7.1	
実施例15	化合物3-76	7.0	27	1912	7.1	
実施例16	化合物3-77	7.0	26	1806	6.9	

産業上の利用可能性

[0141] 本発明の含窒素複素環誘導体は、有機EL素子の電子注入・輸送材料、さらには電子写真感光体の電子注入材料として好適であり、また有機半導体の電子注入材料としても好適である。

請求の範囲

[1] 下記一般式(A-1)または(A-2)で表される含窒素複素環誘導体。 [化1]

$$R^{3a}$$
 R^{2a}
 R^{4a}
 R^{4a}
 R^{5a}
 R^{5a}
 R^{5a}
 R^{5a}
 R^{7a}
 R^{7a}

[式中、 $R^{1a}\sim R^{5a}$ は置換基を示し、 $Ar^{1a}\sim Ar^{3a}$ は単結合または2価の連結基を示す。 HArは下記一般式(A-3)または(A-4)で表される基を示す。 [化2]

$$R^{8a}$$
 R^{10a}
 R^{6a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}
 R^{7a}

(式中、R^{6a}~R^{10a}は置換基を示す。)]

[2] 一般式(A-1)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(1-I)または(1-II)で表される請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。

[化3]

$$R^{3}$$
 R^{1}
 R^{1}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{1

(式中、R¹およびR²は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、R¹およびR²は同時に水素原子ではない。R³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の帰肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁻は、水素原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のトロアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のトロアリール基から選ばれる基を示す。R⁵およびR¹0は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のアリール基から選ばれる基を示す。Ar¹は、置換または無置換のアリール基から選ばれる基を示す。Ar¹は、置換または無置換のアリーレン基、

置換または無置換のヘテロアリーレン基、および2価の置換または無置換の脂肪族 炭化水素基から選ばれる基を示す。)

[3] 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(2-I)または(2-II)で表される請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。 [化4]

$$R^{6}$$
 R^{7}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{7}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}

(式中、 R^4 および R^5 は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、 R^4 および R^5 は同時に水素原子ではない。 R^6 および R^9 は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。 R^7 は、水素原子、置換または無置換のトロアリール基から選ばれる基を示す。 R^7 は、水素原子、置換または無置換のヘテロアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基がら選ばれる基を示す。 R^8 および R^{10} は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無

置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。 Ar²およびAr³は、それぞれ独立に置換または無置換のアリーレン基、置換または無置換のヘテロアリーレン基、および2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基から選ばれる基を示す。)

[4] 一般式(A-1)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(3-I)または(3-II)で表される請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。
「化5]

$$R^{3}$$
 R^{2}
 R^{8}
 R^{8}
 R^{1}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{9}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{1}
 R^{3}
 R^{1}
 R^{2}
 R^{10}

(式中、R¹およびR²は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、R¹およびR²は同時に水素原子ではない。R³は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁶およびR⁹は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の間肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基から選ばれる基を示す。R⁶およびR⁹は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁷は、水

素原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、 および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。R⁸およびR¹⁰は 、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無 置換のアルコキシ基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換の ヘテロアリール基から選ばれる基を示す。)

[5] 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(4-I)または(4-II)で表される請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。 「化6]

(式中、 R^4 および R^5 は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、 R^4 および R^5 は同時に水素原子ではない。 R^6 および R^9 は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。 R^7 は、水素原子、置換または無置換の脂肪族炭化水

素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール 基から選ばれる基を示す。R⁸およびR¹⁰は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無 置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換 のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。)

[6] 一般式(A-2)で表される含窒素複素環誘導体が、下記一般式(5-I)または(5-II)で表される請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。
「化7]

(式中、 R^4 および R^5 は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。ただし、 R^4 および R^5 は同時に水素原子ではない。 R^6 および R^9 は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリ

- ール基から選ばれる基を示す。 R^7 は、水素原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。 R^8 および R^{10} は、水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換の脂肪族炭化水素基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換のアリール基、および置換または無置換のヘテロアリール基から選ばれる基を示す。 Ar^2 は、置換または無置換のアリーレン基、置換または無置換のヘテロアリーレン基、および2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基から選ばれる基を示す。)
- [7] 一般式(A-3)において、 R^{7a} が置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、 一般式(A-1)または(A-2)において、 Ar^{1a} ~ Ar^{3a} が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である請求項1に記載の含窒素複素環誘導体。
- [8] 一般式(1-I)、(2-I)、(3-I)、(4-I)または(5-I)において、 R^7 が、置換または無置換の脂肪族炭化水素基であるか、 $Ar^1 \sim Ar^3$ が2価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である請求項2 \sim 6のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。
- [9] 一般式(1-II)、(2-II)、(3-II)、(4-II)または(5-II)において、Ar¹~Ar³が2 価の置換または無置換の脂肪族炭化水素基である請求項2~6のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体。
- [10] 陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層または複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも一層が、請求項1~9のいずれかに記載の含窒素複素環誘導体を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [11] 含窒素複素環誘導体を、主として発光帯域に含有する請求項10に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [12] 含窒素複素環誘導体を、発光層に含有する請求項10または11に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [13] 有機薄膜層が電子注入層および/または電子輸送層を有し、含窒素複素環誘導体が、電子注入層材料および/または電子輸送層材料である請求項10に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- [14] 電子注入層および/または電子輸送層が還元性ドーパントを含有する請求項13

に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

[15] 還元性ドーパントが、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のの酸化物、アルカリ金属のかロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物、希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体および希土類金属の有機錯体からなる群から選ばれる一種または二種以上の物質である請求項14に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006605

	CATION OF SUBJECT MATTER CO7D235/08, 235/18, 235/20, C	C09K11/06, H05B33/14, 33	3/22		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE					
Minimum docum Int . Cl ⁷	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D235/08, 235/18, 235/20, C09K11/06, H05B33/14, 33/22				
Documentation s	earched other than minimum documentation to the external	nt that such documents are included in the	fields searched		
	ase consulted during the international search (name of ϵ (STN), REGISTRY (STN)	lata base and, where practicable, search te	rms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
Y A	JP 2002-47274 A (Matsushita Co., Ltd.), 12 February, 2002 (12.02.02), (Family: none)	Electric Industrial	1,5,10-15 2-4,6-9		
Y A	WO 2003/060956 A2 (LG CHEM, 24 July, 2003 (24.07.03), Full text (Family: none)	LTD.),	1,5,10-15 2-4,6-9		
P,X	WO 2004/080975 A1 (Idemitsu : 23 September, 2004 (23.09.04) Full text (Family: none)		1-15		
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than		date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consisted when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
	l completion of the international search e, 2005 (14.06.05)	Date of mailing of the international search report 05 July, 2005 (05.07.05)			
	g address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.7 C07D235/08, 235/18, 235/20, C09K11/06, H05B33/14, 33/22

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7 C07D235/08, 235/18, 235/20, C09K11/06, H05B33/14, 33/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAplus (STN), REGISTRY (STN)

間まよった砂はさんファナ

1	C. 関連する	つと認められる文献 ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・	
引用文献の カテゴリー*		引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	Y A	JP 2002-47274 A (松下電器産業株式会社) 2002.02.12 (ファミリーなし)	1, 5, 10–15 2–4, 6–9
	Y A	WO 2003/060956 A2 (LG CHEM, LTD.) 2003.07.24,文献全体 (ファミリーなし)	1, 5, 10–15 2–4, 6–9
	PX '	WO 2004/080975 A1 (出光興産株式会社) 2004.09.23,文献 全体 (ファミリーなし)	1-15

C欄の続きにも文献が列挙されている。

「パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 る文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

国際調査を完了した日 14.06.2005	国際調査報告の発送日 05.07.20	05	•	
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	4 C	3336	
日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915	渕野 留香			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内総	8	452	